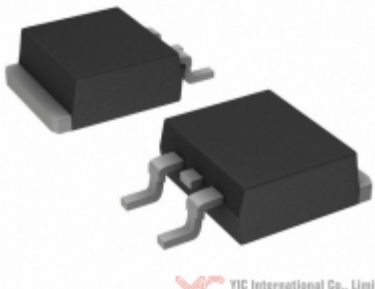
	<h2 style="color: red;">FQB3N80TM</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQB3N80TM
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 3A D2PAK
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 1450 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB3N80TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 3A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1450 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 3A (Tc) Surface Mount D ² PAK (TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	-
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5 Ohm @ 1.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	690pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQB3N80TM ist neu im Original, Suche FQB3N80TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB3N80TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB3N80TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQB3N90TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 3.6A D2PAK</p>	 <p>FQB3N90TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 3.6A D2PAK</p>	 <p>FQB3N60C FCS FQB3N60C FCS</p>	 <p>FQB3N60CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3A D2PAK</p>
 <p>FQB3P20 FSC FQB3P20 FSC</p>	 <p>FQB3N60CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3A D2PAK</p>	 <p>FQB3N80TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A D2PAK</p>	 <p>FQB3N60 VB FQB3N60 VB</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQB32N20CTM	↔ FQB32N30	⇒ FQB33N10	D FQB33N10L	⇒ FQB33N10LTM
⊣ FQB33N10LTM	⊗ FQB33N10TM	D FQB33N10TM	⇒ FQB34N20	⇒ FQB34N20L
⊗ FQB34N20LTM	⊣ FQB34N20LTM	⊗ FQB34N20TM	↔ FQB34N20TM_AM002	⇒ FQB34P10
D FQB34P10TM	⊗ FQB34P10TM	⊣ FQB34P10TM_F085	⊗ FQB3N25TM	⇒ FQB3N25TM
⇒ FQB3N30TM	↔ FQB3N30TM	⊗ FQB3N40TM	⊣ FQB3N40TM	⇒ FQB3N60C
↔ FQB3N80TM	⇒ FQB3N90TM	D FQB3N90TM	⊗ FQB3P20TM	⊣ FQB3P20TM
⊗ FQB3P50TM	D FQB3P50TM	⇒ FQB44N10	↔ FQB44N10TM	⇒ FQB44N10TM
⊣ FQB46N15	⊗ FQB46N15TM	↔ FQB47P06	⇒ FQB47P06TM	⇒ FQB4N20L
⊗ FQB4N20LTM	⊣ FQB4N20LTM	⊗ FQB4N20TM	D FQB4N20TM	⇒ FQB4N25TM
↔ FQB4N25TM	⊗ FQB4N20TM	⊣ FQB4N50TM	⊗ FQB4N50TM	⇒ FQB4N60C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited